

创业邦获悉，镓仁半导体宣布完成数千万天使轮融资，本轮由蓝驰创投领投，禹泉资本跟投。融资资金将用于强化团队、加速氧化镓衬底材料新方法及中试线研发。

杭州镓仁半导体有限公司成立于2022年9月，是一家专注于氧化镓等超宽禁带半导体单晶衬底及外延材料研发、生产和销售的科技型企业。公司开创了非导模法氧化镓单晶生长新技术，突破了国际市场对氧化镓材料的垄断，可提供具有完全自主知识产权的氧化镓单晶衬底材料。公司创始团队源自浙江大学硅材料国家重点实验室和浙江大学杭州国际科创中心。目前，公司已形成一支以中科院院士为首席顾问的研发和生产团队，将持续为我国电力电子等产业的发展提供材料保障。

镓仁半导体创始人张辉表示：由于对电力高效使用的迫切需求，我国功率器件及材料产业将迎来更加快速的发展。镓仁半导体团队经过多年的攻关，已掌握从设备开发、热场设计、晶体生长、晶体加工、外延生长等全套的关键技术，有望破解氧化镓材料的“卡脖子”难题。

蓝驰创投表示：国内新能源汽车、新型电力系统等领域的快速发展，对功率半导体材料和器件提出了越来越高的要求。而氧化镓作为超宽禁带半导体材料，其器件在高压高功率场景具备良好表现和产业化前景。同时，氧化镓的理论成本较低，有望成为未来高性价比功率半导体材料的首选。镓仁半导体团队具备多年半导体材料生长经验，已成为国内氧化镓领域的重要力量之一。蓝驰创投相信，在杨德仁院士和张辉教授的领导下，镓仁科技有望成为国内氧化镓领域的领军企业，进一步加强在宽禁带半导体材料和器件领域的竞争优势。

禹泉资本管理合伙人戈壁川表示：我们看到随着半导体材料以及应用的蓬勃发展，在中高压领域（800V以上），轨道交通、新能源汽车、电力传输等领域中，更高品质的、更低成本、更低电能损耗的器件是市场的刚性需求，而氧化镓可通过熔体法生长，未来生产成本远低于气相生长的碳化硅及氮化镓，氧化镓莫氏硬度同硅接近，远低于碳化硅，非常容易加工，同时器件性能在高压、高电流能有更优异的表现，未来在这些领域同碳化硅、氮化镓形成一定的竞争和替代。我们非常看好镓仁半导体的创始团队，并相信在杨德仁院士及张辉教授的带领下，能够进一步推动氧化镓单晶衬底的产业化，推动氧化镓在半导体领域更大规模的应用。附